

EPITAXIAL PLANAR SILICON DIODE
DIODE AU SILICIUM PLANAR EPITAXIALE

BA111

BA 111 is an al glass variable capacitance diode mainly used for automatic frequency control.

La BA 111 est une diode à capacité variable en boîtier verre particulièrement destinée au contrôle automatique de fréquence.

C 45..... 65 pF

C (2 V)
C (10 V)

1,5 typique

Case DO 7 See outline drawing CB 26 on last pages
Boîtier Voir dessin coté dernières pages



Weight:
Masse : 0,17 g

Marking : Clear, ring at cathode end
Marquage : En clair, anneau côté cathode

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

T_{amb} = 25 °C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Continuous reverse voltage
Tension inverse continue

V_R

20

V

Forward current
Courant direct

I_F

100

mA

Storage temperature
Température de stockage

min
max

T_{stg}

- 55

+ 100

°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

T_{amb} = 25 °C

Unless otherwise stated
Sauf indications contraires

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>		min	max	
Breakdown voltage <i>Tension de claquage</i>	I _R = 100 µA	V _(BR)	20		V
Reverse current <i>Courant inverse</i>	V _R = 10 V	I _R		100	nA
Forward voltage <i>Tension directe</i>	I _F = 60 mA	V _F		0,95	V
Small signal capacitance <i>Capacité différentielle</i>	V _R = 2 V f = 1 MHz	C	45	65	pF
Capacitance ratio <i>Rapport de capacité</i>	f = 1 MHz V _R = 4 V V _R = 10 V	$\frac{C_4}{C_{10}}$		1,3	
Quality factor <i>Coefficient de surtension</i>	f = 50 MHz V _R = 2 V	Q		100	